

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-075661
 (43)Date of publication of application : 15.03.2002

(51)Int.Cl. H05B 33/26
 H05B 33/10
 H05B 33/12
 H05B 33/14
 H05B 33/22

(21)Application number : 2000-262567 (71)Applicant : FUJITSU LTD
 (22)Date of filing : 31.08.2000 (72)Inventor : YOSHIKAWA KOTA

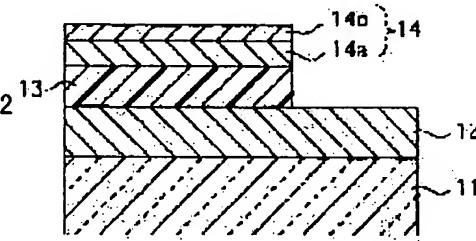
(54) ORGANIC EL ELEMENT AND ORGANIC EL DISPLAY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL element and its manufacturing method in which its manufacturing is easy, degradation of luminescence characteristics by oxygen or moisture is avoided, and generating of a dark spot is inhibited.

SOLUTION: In the organic EL element formed by sandwiching an organic EL layer 13 between an anode 12 and a cathode 14, the cathode 14 has a laminating structure constituted of a 1st electric conduction film 14a contacting the organic EL layer 13, which includes an alkali metal or an alkaline earth metal, and a 2nd electric conduction film 14b containing at least one sort of metals chosen from a group which consists of Ru (ruthenium), Rh(rhodium), Ir(iridium), Os(osmium), and Re (rhenium), or the oxide of those.

有機EL素子（第1の実施の形態）



11 : ガラス基板
 12 : 陽極
 13 : 有機EL層
 14 : 薄極

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

[decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-75661

(P2002-75661A)

(43)公開日 平成14年3月15日 (2002.3.15)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	コード(参考)
H 05 B 33/26		H 05 B 33/26	Z 3K007
33/10		33/10	
33/12		33/12	B
33/14		33/14	A
33/22		33/22	Z

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 9 頁)

(21)出願番号	特願2000-262567(P2000-262567)	(71)出願人	000005223 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号
(22)出願日	平成12年8月31日 (2000.8.31)	(72)発明者	吉川 浩太 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
		(74)代理人	100091672 弁理士 岡本 啓三
			Fターム(参考) 3K007 AB04 AB06 AB11 AB18 BA06 CA01 CB01 DA01 DB03 EA02 EB00 FA01

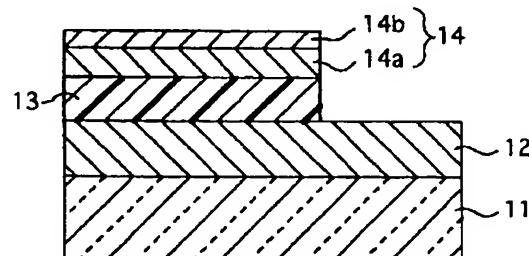
(54)【発明の名称】 有機EL素子及び有機EL表示装置

(57)【要約】

【課題】 製造が容易であるとともに、酸素又は水分等による発光特性の劣化が回避され、ダークスポットの発生が抑制される有機EL素子及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 陽極12と陰極14との間に有機EL層13を挟んで形成された有機EL素子において、陰極14が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み有機EL層13に接触する第1の導電膜14aと、Ru(ルテニウム)、Rh(ロジウム)、Ir(イリジウム)、Os(オスミウム)及びRe(レニウム)からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を含む第2の導電膜14bとの積層構造を有している。

有機EL素子(第1の実施の形態)



11:ガラス基板

12:陽極

13:有機EL層

14:陰極

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、

前記陰極が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み前記有機EL層に接触する第1の導電膜と、Ru (ルテニウム)、Rh (ロジウム)、Ir (イリジウム)、Os (オスミウム) 及びRe (レニウム) からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を含む第2の導電膜との積層構造を有することを特徴とする有機EL素子。

【請求項 2】 陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、前記陰極が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み前記有機EL層に接触する第1の導電膜と、TiN膜、又はTiNとTiとの積層膜からなる第2の導電膜との積層構造を有することを特徴とする有機EL素子。

【請求項 3】 基板上に陽極を形成する工程と、前記陽極の上に有機EL層を形成する工程と、前記有機EL層の上にアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む第1の導電膜を形成する工程と、前記第1の導電膜の上にRu (ルテニウム)、Rh (ロジウム)、Ir (イリジウム)、Os (オスミウム) 及びRe (レニウム) からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を成膜して第2の導電膜を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【請求項 4】 陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、前記陽極と前記有機EL層との間に、Ru (ルテニウム)、Mo (モリブデン) 及びV (バナジウム) からなる群から選択された少なくとも1種の金属を含み、前記有機EL層側の表面のみが酸化されたバッファ層を有することを特徴とする有機EL素子。

【請求項 5】 基板上に陽極を形成する工程と、前記陽極の上にRu、Mo及びVからなる群から選択された少なくとも1種の金属を含むバッファ層を形成する工程と、前記バッファ層の表面のみを酸化させる表面酸化工程と、前記バッファ層の上に有機EL層を形成する工程と、

前記有機EL層の上にアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む陰極を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【請求項 6】 有機EL層を構成するポリマーの共役長を変化させて2以上の発光色が異なる領域を形成したことを特徴とする有機EL表示装置。

【請求項 7】 基板上に第1の電極を形成する工程と、前記第1の電極の上に、光照射により共役長が変化する有機EL材料からなる有機EL層を形成する工程と、

前記有機EL層に部分的に光を照射して共役長を変化さ

せる工程と、

前記有機EL層上に第2の電極を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、一対の電極間に有機EL (electroluminescence) 層を挟んだ構造の有機EL素子及びその製造方法、並びに複数の有機EL素子を配列してなる有機EL表示装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、自発光素子として有機EL素子 (有機LED) が注目されている。有機EL素子は無機EL素子に比べて低電圧で駆動できるという利点があり、且つ従来の無機LEDと比較して複雑な製造プロセスを用いることなく作製できるという利点もある。

【0003】 また、有機EL素子は、現在携帯用機器のディスプレイとして広く使用されている液晶表示装置に比べて、応答速度が速く、素子の構造が簡単であり、且つバックライトが不要であるので、軽量化が可能であるという利点がある。更に、有機EL素子は固体素子であるので衝撃に強いという長所もある。有機EL素子は、陰極と陽極との間にEL発光層 (有機EL層) を挟んだ構造を有している。陽極には仕事関数の大きい金属を用い、陰極には仕事関数の小さい金属を用いて、ホールと電子の供給を円滑にしている。一般的に、陽極には透明導電体であるITO (indium-tin oxide: インジウム酸化スズ) が使用される。また、陰極には、Na (ナトリウム)、Na-K (ナトリウム-カリウム) 合金、Mg

20 (マグネシウム)、Li (リチウム)、Mg/Cu (マグネシウム/銅) 混合物、In (インジウム) 等のアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む金属が使用される。

【0004】 EL発光層には、例えばAlq₃、BeB_q

q₁、DCM、DPVB_i、キナクリドン誘導体及びクマリンなどが用いられる。一般的に、低分子系EL発光層は蒸着法で作製され、高分子系EL発光層はスピンドル法で作製される。従って、高分子系EL発光層のほうが成膜が容易であり、機械的強度が高いという利点がある。

【0005】 また、有機EL素子の動作しきい値電圧を

下げるために、陰極側又は陽極側にバッファ層を形成する試みがなされている。例えば、従来バッファ層として、陽極と有機EL層との間に、酸化ルテニウム (以下、RuO₂と記載する)、酸化モリブデン (以下、MoO₃と記載する) 又は酸化バナジウム (以下、VOと記載する) からなる層が形成されることがある。これらのRuO₂、MoO₃又はVOからなる層は、スパッタ法により形成されている。

【0006】 ところで、有機EL素子では、長時間使用

すると、酸素及び水分の影響により発光効率が低下し、ダーツスポットと呼ばれる不良が発生する。これは、陰極に使用されるアルカリ金属又はアルカリ土類金属が酸化されやすいことに起因している。特開平7-169567号には、酸素や水分による有機EL素子の発光効率の劣化を回避するために、陽極、有機EL層及び陰極の積層体を、酸素を吸着、吸収又は消費する材料からなる層（以下、封止層という）で被覆することが提案されている。そして、封止層の材料として、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム又は銀を、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ペントナイト等の物質に5重量%以下の濃度で担持させたものなどが記載されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本願発明者は、従来の有機EL素子には以下に示す問題点があると考える。すなわち、特開平7-169567号に開示された有機EL素子は、陽極、有機EL層及び陰極の積層体を絶縁性の封止層で被覆するので、陽極及び陰極にそれぞれ引き出し電極を接合し、封止層の外側に引き出す必要がある。このため、製造工程が複雑になり、製品コストの上昇を招く。

【0008】また、前述の如く、動作しきい値電圧を低くするために、RuO_x、MoO_x又はVOからなるバッファ層をスパッタ法により形成することがある。しかし、この方法では、大きな凹凸が形成されてしまうという欠点がある。例えば、スパッタ法でRuO_x層を300Åの厚さに形成しようとすると、高さが500~1000Åのヒロックが局所的に生じてしまう。このため、有機EL層の厚さを薄くすると短絡不良が発生する可能性がある。

【0009】更に、有機EL素子によるフルカラーの画像表示装置を作製する場合、赤色発光の有機EL素子、緑色発光の有機EL素子及び青色発光の有機EL素子を水平方向及び垂直方向に一定の順番で配列させることが必要である。従って、有機EL層を微細加工する技術が必要となる。半導体装置の製造に使用される微細加工技術として、リフトオフ法やエッチング法が知られている。しかし、単色の画像表示装置の場合は、例えば各画素の上部電極（陰極）をリフトオフ法で形成することが考えられるが、フルカラーの表示装置の製造にリフトオフ法を適用することは困難である。また、有機EL層は、低分子系又は高分子系の有機物であるので、ドライエッチングなどの微細加工技術で加工することもできない。

【0010】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、製造が容易であるとともに、酸素又は水分等による発光特性の劣化が回避され、ダーツスポットの発生が抑制される有機EL素子及びその製造方法を提供することを目的とする。また、本発明は、バッファ層の表

面の凹凸が小さく、短絡不良の発生を防止できる有機EL素子及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0011】更に、本発明は、画像表示可能な多色発光の有機EL表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】本願請求項1に記載の有機EL素子は、陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、前記陰極が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み前記有機EL層に接触する第1の導電膜と、Ru（ルテニウム）、Rh（ロジウム）、Ir（イリジウム）、Os（オスミウム）及びRe（レニウム）からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を含む第2の導電膜との積層構造を有する。

【0013】Ru、Rh、Ir、Os及びRe等の準貴金属を含む第2の導電膜は、Ru、Rh、Ir、Os及びRe等の準貴金属が酸化することにより、第1の導電膜への酸素及び水分の進入を防止する。また、Ru、Rh、Ir、Os及びRe等の準貴金属は、その酸化物が導電性を有するので、酸化しても電極としての機能が損なわれることはない。これにより、本発明の有機EL素子は、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む第1の導電膜の酸化が防止され、長期間にわたってダーツスポットの発生が回避される。

【0014】第2の導電膜として、TiN膜、又はTiNとTiとの積層膜と使用しても、同様に第1の導電膜への酸素及び水分の侵入を防止することができ、信頼性の高い有機EL素子を得ることができる。本願請求項3に記載の有機EL素子の製造方法においては、基板上に陽極、有機EL層を形成した後、スパッタ法によりアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む第1の導電膜を形成し、その上にRu、Rh、Ir、Os及びReからなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を成膜して、第2の導電膜を形成する。

【0015】本発明においては、陽極、有機EL層及び陰極の積層体を絶縁膜で被覆しなくとも、第2の導電膜により第1の導電膜中のアルカリ金属又はアルカリ土類金属の酸化を防止することができる。従って、長期間にわたって信頼性が高い有機EL素子を、容易に製造することができる。本願請求項4に記載の有機EL素子においては、陽極と有機EL層との間に、Ru（ルテニウム）、Mo（モリブデン）及びV（バナジウム）からなる群から選択された少なくとも1種の金属を含み、有機EL層側の表面のみが酸化されたバッファ層を有している。

【0016】例えば、スパッタ法により、Ru、Mo及びVのうちの少なくとも1種の金属を含む導電膜（バッファ層）を形成し、短時間アニール、レーザアニール、プラズマ酸化又は陽極酸化などの方法により、導電膜の

表面のみを酸化させる。これにより、薄い酸化膜を形成することができ、バッファ層の表面の凹凸を小さくすることができる。従って、有機EL層の厚さを薄くしても、短絡の発生が回避される。

【0017】本願請求項6に記載の有機EL表示装置は、有機EL層を構成するポリマーの共役長を変化させて、2以上の発光色が異なる領域を形成している。例えば、ポリ【3-(4-アルキルフェニル)チオフェン】は赤色発光の有機EL材料であるが、紫外線を照射することにより共役長が変化し、紫外線の照射量に応じて緑色発光又は青色発光するようになる。このような有機EL材料を使用することにより、多色発光の有機EL表示装置を容易に製造することができる。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

(第1の実施の形態) 図1は本発明の第1の実施の形態の有機EL素子を示す断面図である。ガラス基板11の上には、陽極12としてITO膜が約2000Åの厚さに形成されている。また、陽極12の上の所定の領域には有機EL層(発光層)13として、ポリ【3-(4-アルキルフェニル)チオフェン】膜が約1500Åの厚さに形成されている。

【0019】更に、有機EL層13の上には、陰極14としてMgを含む導電体からなる第1の導電膜14aと、Ruを含む導電体からなる第2の導電膜14bとの2層構造の積層膜が形成されている。この例では、第1の導電膜14aの厚さは約1000Åであり、第2の導電膜14bの厚さは約500Åである。陽極12はITOに限定するものではなく、仕事関数が大きい導電体を使用することができる。但し、光を基板11側に出射するのであれば、陽極12は光を透過する導電体であることが必要である。

【0020】第1の導電膜14aは、仕事関数が小さいアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む導電体で形成すればよい。例えば、第1の導電膜14aの材料としては、MgAg、AlLi及びLiF等を使用することができる。ここでは、第2の導電膜14aはMgAgからなるものとする。また、第2の導電膜14bは、上記のRuを含む導電体に限定されるものではなく、酸素に対するバリア性が高い導電体、具体的には、Ru、Rh、Ir、Os及びReからなる群から選択された金属又はその酸化物により形成すればよい。Ru、Rh、Ir、Os及びReは、その酸化物も導電性を有している。従って、酸化により陰極14の導電性が損なわれることはない。

【0021】また、第2の導電膜14bとして、TiN膜、又はTiNとTiとの積層膜(TiN/Ti膜という)を使用してもよい。これらの膜も酸素に対するバリア性が良好であり、第1の導電膜14aの酸化を防止す

ることができる。また、TiN膜及びTiN/Ti膜も、酸素を含む雰囲気に長時間さらされても、導電性が損なわれることはない。

【0022】更に、第2の導電膜14bとして、Ru、Rh、Ir、Os及びReからなる群から選択された金属又はその酸化物を含む導電膜と、TiN膜又はTiN/Ti膜との積層膜を使用してもよい。このように構成された本実施の形態の有機EL素子において、陽極12に正、陰極14に負の電圧を印加すると、有機EL層13が発光する。

【0023】本実施の形態においては、アルカリ金属であるMgを含む第1の導電膜14aの上にRuを含む第2の導電膜14bが形成されているので、有機EL素子が酸素又は水分を含む雰囲気中に長時間さらされたとしても、第2の導電膜14b中のRuが酸化して第1の導電膜14aへの酸素の侵入を防止する。従って、第1の導電膜14a中のMgの酸化が回避される。

【0024】これにより、本実施の形態の有機EL素子は、酸素又は水分による発光特性の劣化が回避され、ダーラクスポットの発生が抑制される。また、第1の導電膜14aの酸化が回避されるので、有機EL層13と第1の導電膜14aとの間の剥離も防止される。更に、陽極12、有機EL層13及び陰極14の積層体を絶縁物で被覆する必要がなく、製造が容易である。

【0025】以下、本実施の形態の有機EL素子の製造方法について説明する。まず、スパッタ法により、ガラス基板11の上側全面にITO膜を約2000Åの厚さに成膜する。次に、スピノコーティング法により、ガラス基板11の上側全面にポリ【3-(4-アルキルフェニル)チオフェン】を1500Åの厚さに成膜し、有機EL層13とする。なお、本実施の形態においては、有機EL層13の材料が、上記のポリ【3-(4-アルキルフェニル)チオフェン】に限定されるものではなく、低分子系又は高分子系の種々の有機EL発光材料を使用することができる。

【0026】次に、スパッタ法により、有機EL層13の上にMgAgを約1000Åの厚さに成膜して第1の導電膜14aを形成し、更にRuを500Åの厚さに成膜して第2の導電膜14bを形成する。次いで、メタルマスクを用いてAu又はAl等の金属をスパッタリングし、陽極12及び陰極14にそれぞれ接続した一対の端子を形成する。これにより、本実施の形態の有機EL素子が完成する。

【0027】なお、図2に示すように、陽極12をストライプ状に形成し、陰極14を陽極12に対し直角に交差する方向にストライプ状に形成することにより、ガラス基板11上に複数の有機EL素子(陽極12と陰極14が交差する部分)15がマトリクス状に配列した表示装置とすることができる。この表示装置においては、単純マトリクス型液晶表示装置と同様に、垂直方向に並ぶ

複数の陽極12に水平同期信号に同期したタイミングで正の信号を順番に供給し、1水平同期期間内に水平方向に並ぶ複数の陰極14に順番に負の信号を供給することにより、所望の画像を表示することができる。

【0028】また、本発明は、アクティブマトリクス型有機EL表示装置に適用することもできる。すなわち、図3に示すように、陰極14を各画素毎に形成し、データ線16、電源供給線17及び走査線18に接続されたスイッチ素子19を介して陰極14に印加される電圧を各画素毎に制御することにより、所望の画像を表示することができる。この場合、陽極12は各画素共通の電極となるので、パターニングする必要はない。

【0029】更に、上記実施の形態においては、陽極12の上に直接有機EL層13を形成し、有機EL層13の上に直接陰極14を形成した場合について説明したが、陽極12と有機EL層13との間、又は有機EL層13と陰極14との間にバッファ層を設けてもよい。

(第2の実施の形態) 図4は本発明の第2の実施の形態の有機EL素子の製造方法を示す断面図である。本実施の形態は陽極と有機EL層との間にバッファ層を有する有機EL素子の製造方法の例である。

【0030】まず、図4(a)に示すように、スパッタ法により、ガラス基板21の上側にITOを2000Åの厚さに成膜し、陽極(下部電極)22とする。次に、スパッタ法により、陽極22の上にRu(ルテニウム)を300Åの厚さに成膜してバッファ層23とする。そして、ランプによって加熱するRTA(Rapid Thermal Annealing)装置を使用し、700℃の温度で3~5秒間の短時間アニール(RTA)を行う。この短時間アニールにより、バッファ層23の表面のRuが酸化される。この場合、RuOが極めて短時間に生成されるので、RuOの粒径が小さく、バッファ層23の表面に大きな凹凸が形成されることが回避される。

【0031】なお、バッファ層23の厚さ(RTA前の厚さ)は、500Å以下とすることが好ましい。これは、バッファ層23の厚さが500Åを超えると、EL発光層23で発生した光がバッファ層23で吸収され、見かけの発光強度が低下するためである。また、バッファ層23の材料としては、上記のRu以外にもMo又はVを使用することができる。

【0032】次に、スピニコーティング法により、バッファ層23の上にポリ[3-(4-アルキルフェニル)チオフェン]を約1500Åの厚さに成膜し、EL発光層24とする。EL発光層24の材料は上記のポリ[3-(4-アルキルフェニル)チオフェン]に限定されるものではなく、低分子系又は高分子系の種々の有機EL発光材料を使用することができる。

【0033】そして、スパッタ法により、有機EL層24の上にAlLiを約200Åの厚さに成膜し、陰極(上部電極)25とする。これにより、本実施の形態の

有機EL素子が完成する。なお、陰極25の材料は上記AlLiに限定されるものではなく、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む導電体を使用すればよい。また、第1の実施の形態で示したように、陰極25を2層構造としてもよい。

【0034】以下、上記の有機EL素子を実際に製造し、動作しきい値電圧及びバッファ層の表面凹凸を実際に測定した結果について説明する。有機EL層24の材料としてTDP/Alq₃を用い、上記の方法により有機EL素子を形成して、動作しきい値電圧を測定した。その結果、バッファ層23がない場合は発光開始電圧が7Vであったのに対し、上記方法によりバッファ層23を形成した場合は3.5Vとなり、しきい値電圧の低下が確認された。

【0035】また、バッファ層23の表面の凹凸を測定したところ、本実施の形態では50Å~100Åであった。一方、バッファ層としてRuO₂をスパッタリングした場合は、バッファ層の表面の凹凸が500Å~1000Åであった。これにより、本実施の形態の有効性が確認された。本実施の形態によれば、バッファ層23としてRu、Mo又はVの金属膜を形成し、RTAによりバッファ層23の表面を酸化して、動作しきい値電圧を下げるのに有効なRuO、MoO又はVOを形成する。この場合、バッファ層23の表面を短時間で酸化させるので、バッファ層23の表面に大きな凹凸が形成されることが回避される。これにより、有機EL層24の厚さを薄くしても陽極22と陰極25との短絡が回避され、動作しきい値電圧の低い有機EL素子が作製される。

【0036】なお、本実施の形態も、第1の実施の形態と同様に単純マトリクス型有機EL表示装置及びアクティブマトリクス型有機EL表示装置に適用することができる。また、上記の実施の形態においては、ランプにより加熱するRTA装置を使用してバッファ層23の表面を酸化したが、レーザ照射、プラズマ酸化法または陽極酸化法によりバッファ層23の表面を酸化させてもよい。

【0037】レーザ照射によりバッファ層23の表面を酸化せる場合は、例えばXeClエキシマレーザを使用し、レーザビームを幅が狭い矩形状に成形して幅方向にスキャンし、バッファ層23の表面を短時間で酸化させる。レーザビームのエネルギーは、例えば390mJ/cm²とする。また、プラズマ酸化法によりバッファ層23の表面を酸化せる場合は、酸素を含むプラズマを発生し、このプラズマにバッファ層23の表面をさらすことにより、バッファ層23の表面を酸化させる。例えば、RF O₂プラズマ法によって、処理時間が10分間、圧力が40Pa、パワーが200Wの条件でプラズマ酸化処理を行う。

【0038】更に、陽極酸化法によりバッファ層23の表面を酸化せる場合は、例えば電解液として酒石酸と

エチレングリコールとアンモニア溶液との混合液を使用し、陽極としてPt（白金）電極を使用する。そして、5 mAの定電流を流してバッファ層23の表面を陽極酸化し、RuO₂膜を析出させる。これらの方法によりバッファ層23の表面を酸化させた場合も、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0039】（第3の実施の形態）図5、図6は本発明の第3の実施の形態の有機EL表示装置の製造方法を示す平面図である。本実施の形態は、フルカラーの有機EL表示装置の製造方法の例を示している。まず、図5(a)に示すように、ガラス基板31の上側全面にITOをスパッタリングし、厚さが約2000 ÅのITO膜を成膜した後、フォトリソグラフィによりITO膜をストライプ状にバーニングして陽極（下部電極）32とする。この場合、陽極32の幅は例えば20 μmとする。

【0040】次に、スピニコーティング法により、ガラス基板31上の表示領域全面にポリ[3-(4-アルキルフェニル)チオフェン]を1500 Åの厚さに成膜し、EL発光層33とする。本発明において、EL発光層の材料は上記のポリ[3-(4-アルキルフェニル)チオフェン]に限定されるものではないが、光の照射により共役長が変化するポリマーであることが必要である。

【0041】そして、図5(b)に示すように、赤色画素領域(R)以外の領域（すなわち、緑色画素領域(G)及び青色画素領域(B)）にArFレーザ光を1000 mJ/cm²の条件で照射する。これにより、レーザ照射されていない部分のEL発光層は赤色（波長約650 nm）に発光し、レーザ照射された部分のEL発光層は、共役長が短くなつて緑色（波長約510 nm）に発光するようになる。図5(b)では、有機EL層のうち赤色発光する部分を33Rで表し、緑色発光する部分を33Gで表している。

【0042】なお、レーザ光の照射強度とEL発光層の発光色との関係はEL発光層の材料により異なるので、材料に合わせてレーザ光の照射条件を適宜変更する必要がある。次に、図6(a)に示すように、EL発光層のうち、青色画素領域にArFレーザ光を4000 mJ/cm²の条件で照射する。これにより、レーザ照射された部分のEL発光層は、共役長が更に短くなつて青色（波長約460 nm）に発光するようになる。図6(a)では、有機EL層のうち青色発光する部分を33Bで表している。

【0043】次いで、リフトオフ法により、図6(b)に示すように、EL発光層33の上に陰極（上部電極）34を形成する。すなわち、ガラス基板31の上側全面にフォトレジストを塗布し、露光及び現像工程を経て、レジスト膜に上部電極形成用の窓を開口する。そして、ガラス基板31の上側全面にAl₂O₃を2000 Åの厚

さにスパッタリングした後、レジスト膜上のAl₂O₃膜をレジストとともに除去する。これにより、陰極34が形成される。なお、陰極34の材料は上記のAl₂O₃に限定されるものではなく、仕事関数が小さいアルカリ金属又はアルカリ金属を含む導電体を使用すればよい。

【0044】本実施の形態では、上述の如く、レーザ光の照射により共役長が変化して発光色が変化するポリマーを使用してRGBの発光色の画素を形成する。すなわち、有機EL層33を画素毎に分割するドライエッチングなどの微細加工技術を使用しなくとも、多色発光の有機EL素子を形成できるので、製造工程が少なく、製造コストが低減される。そして、RGB3色の画素をもつフルカラー表示のEL表示装置が実現される。

【0045】なお、上記実施の形態では陽極（下部電極）32の上に直接EL発光層33を形成し、EL発光層33の上に直接陰極（上部電極）34を形成したが、陽極32とEL発光層33との間、及びEL発光層33と上部電極34との間の少なくとも一方にバッファ層を形成してもよい。また、上記実施の形態では単純マトリクス型有機EL表示装置の製造方法について説明したが、本発明をアクティブマトリクス型有機EL表示装置の製造に適用することもできる。

【0046】（付記1）陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、前記陰極が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み前記有機EL層に接触する第1の導電膜と、Ru（ルテニウム）、Rh（ロジウム）、Ir（イリジウム）、Os（オスミウム）及びRe（レニウム）からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を含む第2の導電膜との積層構造を有することを特徴とする有機EL素子。

【0047】（付記2）陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、前記陰極が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み前記有機EL層に接触する第1の導電膜と、TiN膜、又はTiNとTiとの積層膜からなる第2の導電膜との積層構造を有することを特徴とする有機EL素子。

（付記3）陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含み前記有機EL層に接触する第1の導電膜と、Ru（ルテニウム）、Rh（ロジウム）、Ir（イリジウム）、Os（オスミウム）及びRe（レニウム）からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を含む膜と、TiN膜、又はTiNとTiとの積層膜からなる第2の導電膜との積層構造を有することを特徴とする有機EL素子。

【0048】（付記4）基板上に陽極を形成する工程と、前記陽極の上に有機EL層を形成する工程と、前記有機EL層の上にアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む第1の導電膜を形成する工程と、前記第1の導電膜

の上にRu(ルテニウム)、Rh(ロジウム)、Ir(イリジウム)、Os(オスミウム)及びRe(レニウム)からなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を成膜して第2の導電膜を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【0049】(付記5)陽極と陰極との間に有機EL層を挟んで形成された有機EL素子において、前記陽極と前記有機EL層との間に、Ru(ルテニウム)、Mo(モリブデン)及びV(バナジウム)からなる群から選択された少なくとも1種の金属を含み、前記有機EL層側の表面のみが酸化されたバッファ層を有することを特徴とする有機EL素子。

【0050】(付記6)基板上に陽極を形成する工程と、前記陽極の上にRu、Mo及びVからなる群から選択された少なくとも1種の金属を含むバッファ層を形成する工程と、前記バッファ層の表面のみを酸化させる表面酸化工程と、前記バッファ層の上に有機EL層を形成する工程と、前記有機EL層の上にアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む陰極を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【0051】(付記7)前記バッファ層を500Å以下の厚さに形成することを特徴とする付記6に記載の有機EL素子の製造方法。

(付記8)前記表面酸化工程では、短時間アニール(Rapid Thermal Annealing)により前記バッファ層の表面のみを酸化させることを特徴とする付記6に記載の有機EL素子の製造方法。

【0052】(付記9)前記表面酸化工程では、レーザアニール、プラズマ酸化及び陽極酸化のいずれかの方法により前記バッファ層の表面のみを酸化させることを特徴とする付記6に記載の有機EL素子の製造方法。

(付記10)有機EL層を構成するポリマーの共役長を変化させて2以上の発光色が異なる領域を形成したことを特徴とする有機EL表示装置。

【0053】(付記11)前記有機EL層に、共役長が相互に異なる赤色発光領域、緑色発光領域及び青色発光領域を有することを特徴とする付記10に記載の有機EL表示装置。

(付記12)基板上に第1の電極を形成する工程と、前記第1の電極の上に、光照射により共役長が変化する有機EL材料からなる有機EL層を形成する工程と、前記有機EL層に部分的に光を照射して共役長を変化させる工程と、前記有機EL層上に第2の電極を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。

【0054】(付記13)前記有機EL層の材料として、光を照射する前の状態で赤色発光するポリマーを使用することを特徴とする付記12に記載の有機EL表示装置の製造方法。

【0055】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の有機EL素子によれば、陰極が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む第1の導電膜と、Ru、Rh、Ir、Os及びReからなる群から選択された少なくとも1種の金属又はその酸化物を含む第2の導電膜との積層構造を有しているので、第1の導電膜中のアルカリ金属又はアルカリ土類金属の酸化が防止され、長期間にわたってダークスポットの発生を回避できる。また、比較的簡単な工程で製造することができる。第2の導電膜としてTiN膜、又はTiとTiNとの積層膜を使用した場合も、同様の効果が得られる。

【0056】また、本発明の他の有機EL素子によれば、陽極と有機EL層との間に、Ru、Mo及びVからなる群から選択された少なくとも1種の金属を含むバッファ層を有し、該バッファ層の有機EL層側表面のみが、短時間アニール、レーザアニール、プラズマ酸化又は陽極酸化等の方法により酸化されている。このため、バッファ層の表面の凹凸が小さく、有機EL層を薄くしても、短絡等の不具合の発生が回避される。

【0057】更に、本発明の有機EL表示装置は、有機EL層を構成するポリマーの共役長を変化させることにより異なる色で発光する領域を形成するので、多色発光の有機EL表示装置を容易に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の第1の実施の形態の有機EL素子を示す断面図である。

【図2】図2は本発明の第1の実施の形態の有機EL素子の陽極及び陰極の配置の例を示す平面図である。

【図3】図3は本発明の第1の実施の形態をアクティブマトリクス型有機EL表示装置に適用した例を示す平面図である。

【図4】図4は本発明の第2の実施の形態の有機EL素子の製造方法を示す断面図である。

【図5】図5は本発明の第3の実施の形態の有機EL表示装置の製造方法を示す平面図(その1)である。

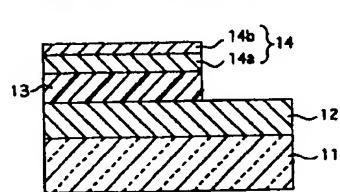
【図6】図6は本発明の第3の実施の形態の有機EL表示装置の製造方法を示す平面図(その2)である。

【符号の説明】

- 1, 21, 31…ガラス基板、
- 12, 22, 32…陽極、
- 13, 24, 33…有機EL層(EL発光層)、
- 14, 25, 34…陰極、
- 14a…第1の導電膜、
- 14b…第2の導電膜、
- 15…有機EL素子、
- 16…データ線、
- 17…電源供給線、
- 18…走査線、
- 19…スイッチ素子、
- 23…バッファ層。

[図1]

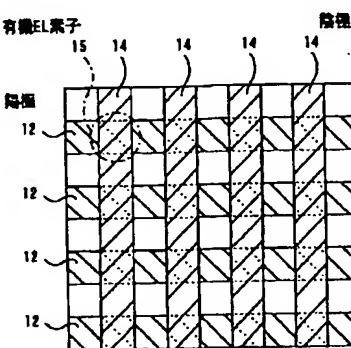
有刺毛子(第1の寒風の形態)



- 11: ガラス基板
- 12: 開槽
- 13: 有機EL層
- 14: 防護

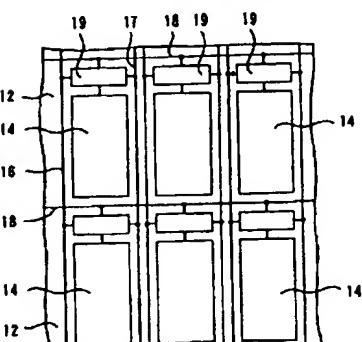
[図2]

組み込み情報の配置例



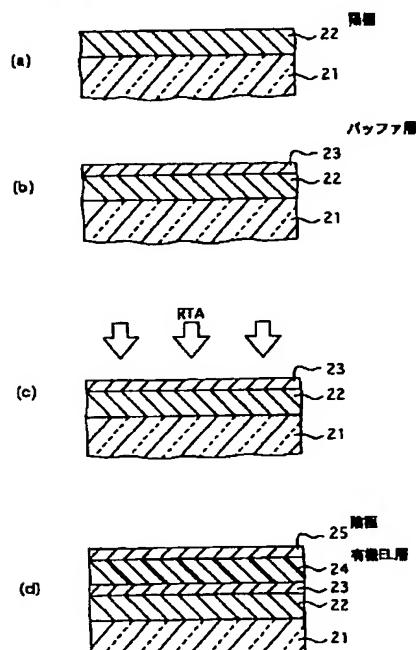
[図3]

アクティブマトリクス型有機EL素子



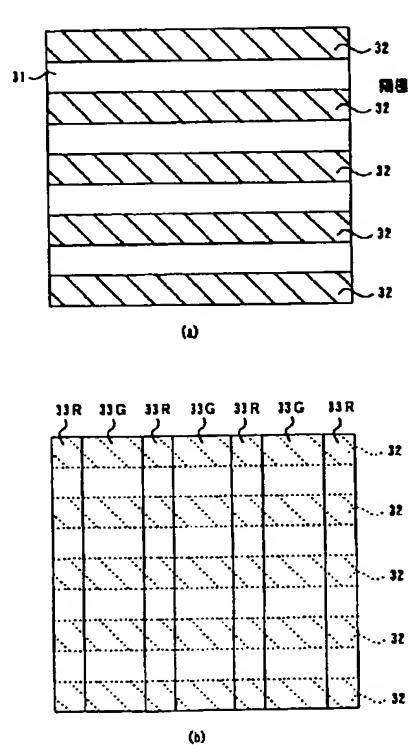
[图4]

有機EL電子の製造方法（第2の実施の形態）

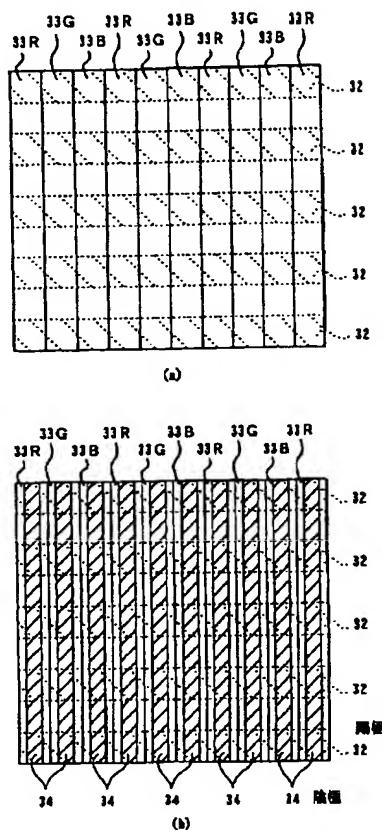


[図5]

有機EL電子の整造方法（第3の実施の形態）



【図6】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADING TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.